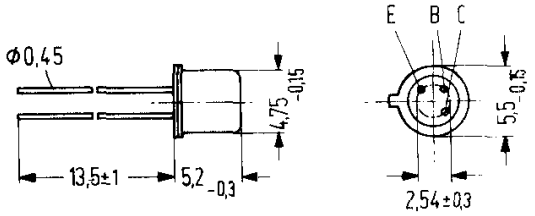
BCX 23 ist ein epitaktischer PNP-Silizium-Planar-Transistor im Metall-Gehäuse 18 A 3 DIN 41 876 (TO–18). Besonders in NF-Vor- und Treiberstufen, sowie für universelle Anwendung bei höheren Sperrspannungen geeignet.

Typ	Bestellbezeichnung
BCX 23	Q62702–C732



Gewicht etwa 0,33 g Maße in mm

Grenzdaten (T_U = 25 °C)

Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CES}$	125	V
Kollektor-Emitter-Spannung	$-U_{CEO}$	125	V
Emitter-Basis-Spannung	$-U_{ERO}$	5	V
Kollektor-Strom	$-I_C$	800	mA
Kollektor-Spitzenstrom	$-I_{CM}$	1	A
Basis-Strom	$-I_B$	100	mA
Sperrschichttemperatur	T_j	200	°C
Lagertemperatur	T_S	−65 bis +200	°C
Gesamtverlustleistung (T_U = 25 °C)	P_{tot}	450	mW
Gesamtverlustleistung (T_U = 45 °C)	P_{tot}	1,55	W
Wärmewiderstand			
Kollektor-Sperrschicht – Luft	R_{thJU}	390	K/W
Kollektor-Sperrschicht – Gehäuse	R_{thJG}	100	K/W

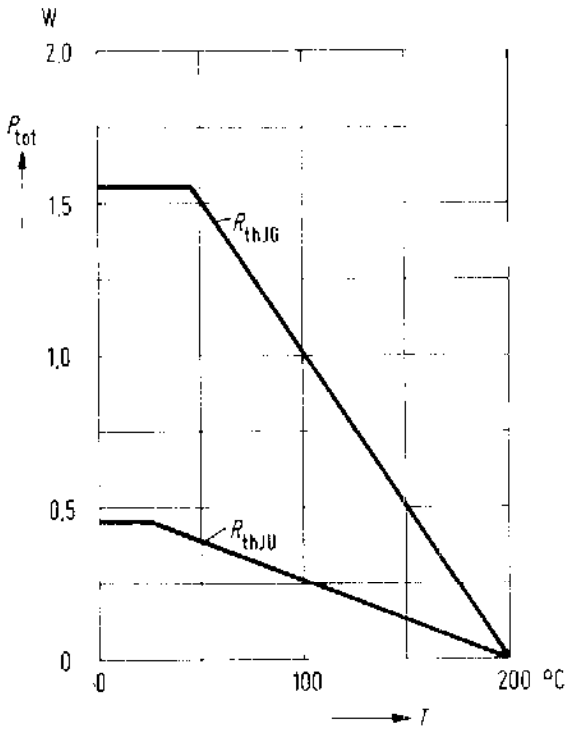
Statische Kenndaten (T_U = 25 °C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung ($-I_C$ = 10 mA)	$-U_{(BR)CEO}$	> 125	V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung ($-I_C$ = 100 µA)	$-U_{(BC)CES}$	> 125	V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung ($-I_E$ = 100 µA)	$-U_{(BR)EBO}$	> 5	V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ($-I_C$ = 300 mA; $-I_B$ = 30 mA)	$-U_{CEsat}$	≦ 0,9	V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung ($-I_C$ = 300 mA; $-I_B$ = 30 mA)	$-U_{BEsat}$	≦ 1,4	V
Kollektor-Emitter-Reststrom ($-U_{CE}$ = 100 V)	$-I_{CES}$	≦ 100	nA
($-U_{CE}$ = 100 V; T_U = 150 °C)	$-I_{CES}$	≦ 10	µA
Emitter-Basis-Reststrom ($-U_{EB}$ = 4 V)	$-I_{EBO}$	≦ 100	nA
Kollektor-Basis-Gleichstromverhältnis ($-I_C$ = 100 mA; $-U_{CE}$ = 1 V)	B	≧ 63	—
($-I_C$ = 200 mA; $-U_{CE}$ = 1 V)	B	≧ 40	—

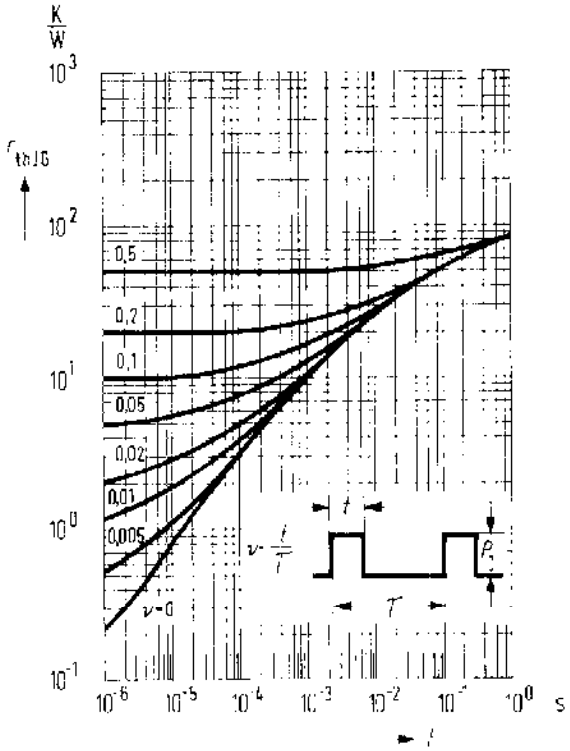
Dynamische Kenndaten (T_U = 25 °C)

Transitfrequenz ($-I_C$ = 10 mA; $-U_{CE}$ = 5 V; f = 20 MHz)	f_T	100	MHz
Leerlauf-Ausgangskapazität ($-U_{CB}$ = 10 V; $-I_E$ = 0; f = 1 MHz)	C_{ob}	12	pF

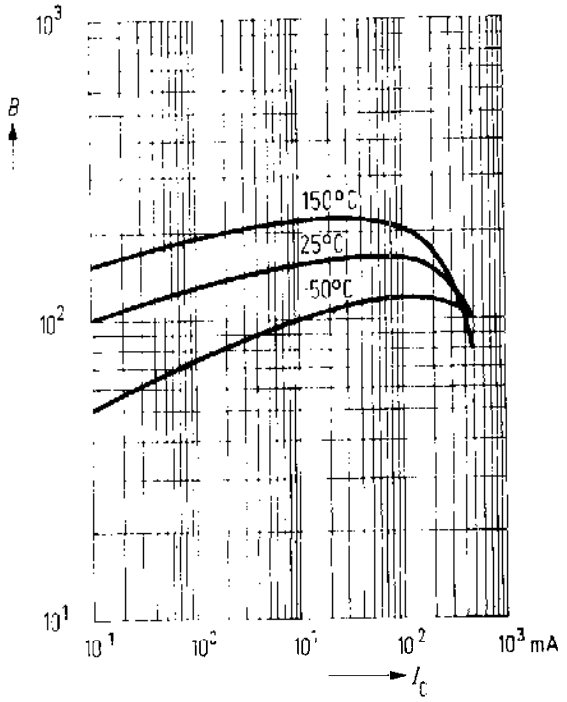
Temperaturabhängigkeit der zulässigen Gesamtverlustleistung
$P_{tot} = f(T)$; R_{th} = Parameter



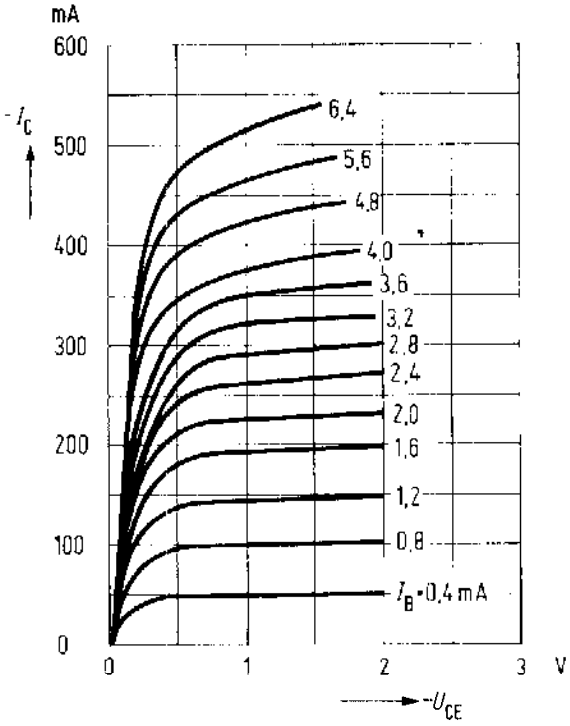
Zulässige Impulsbelastbarkeit
$r_{thJG} = f(t)$; ν = Parameter



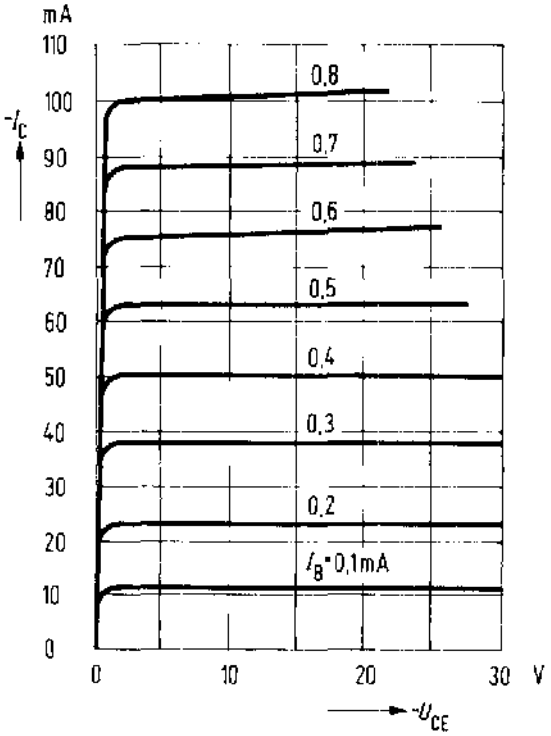
Stromverstärkung B = $f(I_C)$
T_U = Parameter; U_{CE} = 1 V



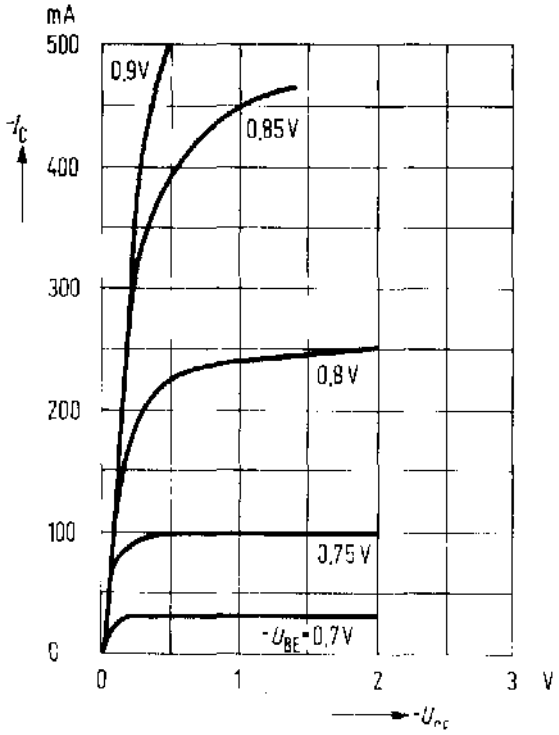
Ausgangskennlinien $I_C = f(U_{CE})$
I_B = Parameter (Emitterschaltung)



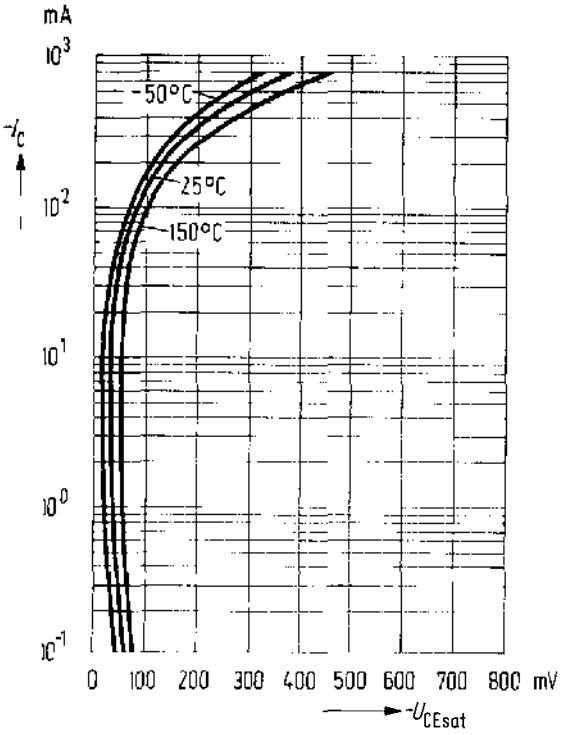
Ausgangskennlinien $I_C = f(U_{CE})$
I_B = Parameter (Emitterschaltung)



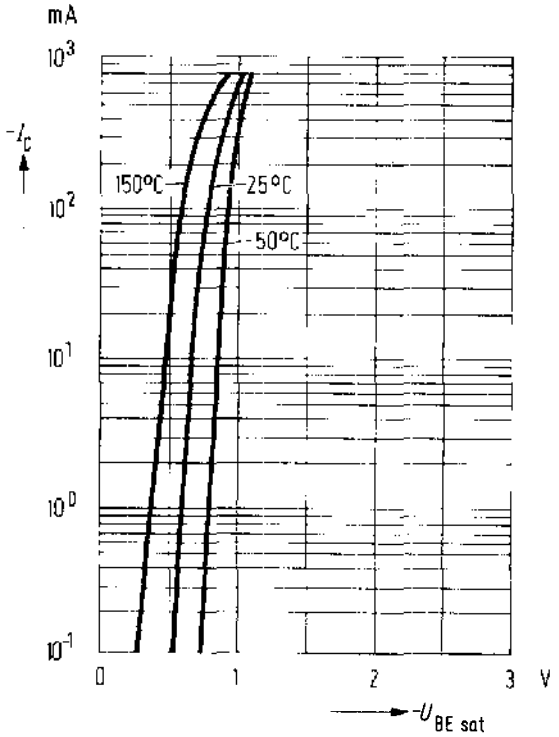
Ausgangskennlinien $I_C = f(U_{CE})$
U_{BE} = Parameter (Emitterschaltung)



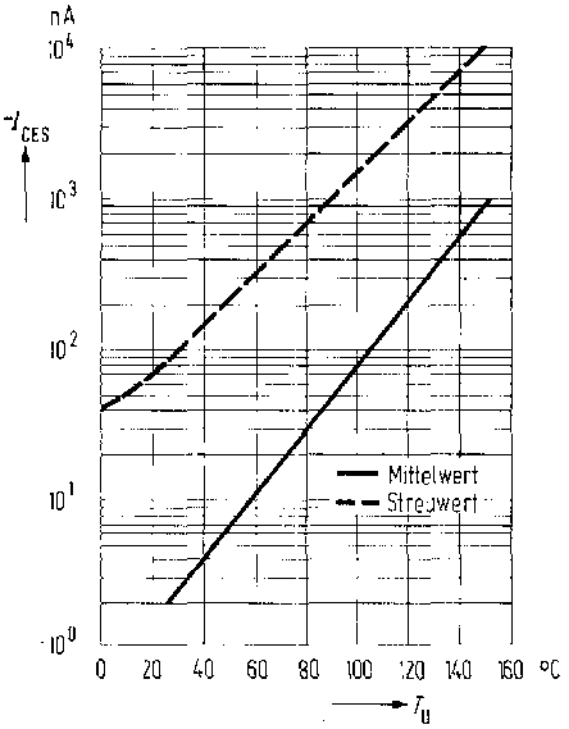
Sättigungsspannung $U_{CEsat} = f(I_C)$
B = 10; T_U = Parameter



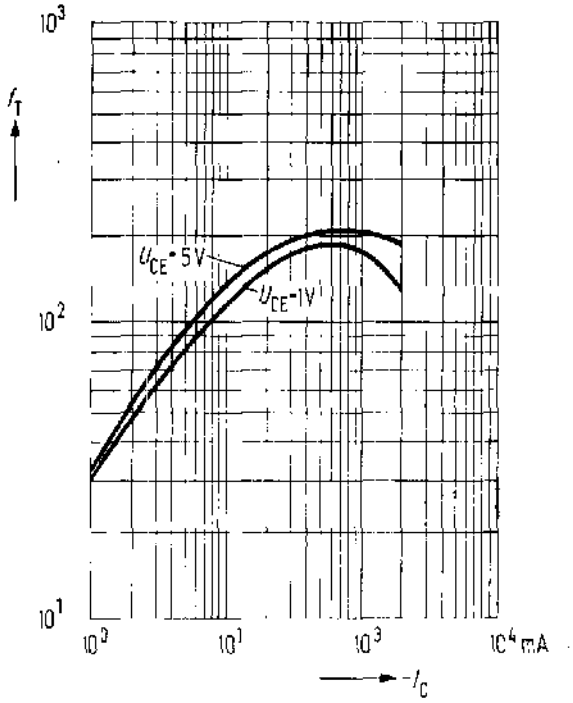
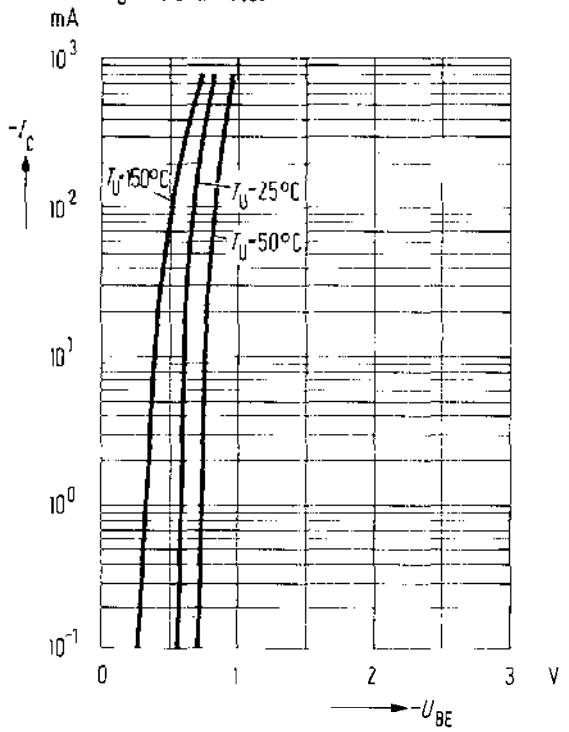
Sättigungsspannung $U_{BEsat} = f(I_C)$
B = 10; T_U = Parameter



Temperaturabhängigkeit des Reststromes $I_{CES} = f(T_U)$
für maximal zulässige Sperrspannung



Transitfrequenz $f_T = f(I_C)$
U_{CE} = Parameter; f_M = 20 MHz; T_U = 25 °C



Kollektorstrom $I_C = f(U_{BE})$
T_U = Parameter